

**2П7102Д, Д91, Д92, Д93**

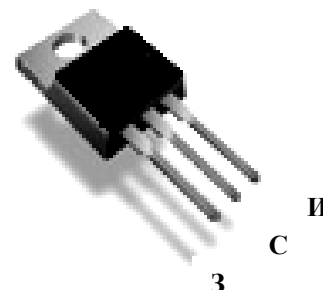
## ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЙ N-КАНАЛЬНЫЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ И N-КАНАЛОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ, ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ АППАРАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

\* Зарубежный аналог - **IRFZ44**

Изготавливается в корпусах:

**2П7102Д - КТ-28-2**  
**2П7102А91- КТ-90 (D<sup>2</sup>РАК**  
**2П7102А93- SMD2**  
**(ТО-254-в проекте)**



**КТ-28-2**

(**D<sup>2</sup>РАК** цоколевка аналогичная )

### ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Предельные значения
Макс. допустимое напряжение сток-исток	U <sub>си макс</sub>	В	60
Макс. допустимое напряжение затвор-исток	U <sub>зи макс</sub>	В	±20
Макс. допустимый пост. ток стока 25°C	I <sub>с макс</sub>	А	50
при T <sub>корп</sub> ≤ 100°C			36
Макс. допустимый импульсный ток стока	I <sub>с (и) макс</sub>	А	200
Макс. допустимый постоянный прямой ток диода	I <sub>пр макс</sub>	А	50
Макс. допустимый импульсный прямой ток диода	I <sub>пр (и) макс</sub>	А	200
Макс. допустимая энергия одиночного импульса, рассеиваемая транзистором в режиме лавинного пробоя (T <sub>п нач.</sub> = 25°C, U <sub>си</sub> = 25 В, R <sub>г</sub> = 25 Ом, I <sub>с</sub> = 51 А, L = 44 мкГн)	E <sub>АС</sub>	Дж	0.1
Макс. допустимая постоянная рассеиваемая мощность (T <sub>корп.</sub> = 25°C)	P макс	Вт	150
Тепловое сопротивление переход-корпус (в КТ-28-2)	R <sub>т п- корп</sub>	°С/ Вт	1.0
Тепловое сопротивление переход-среда	R <sub>т п- ср</sub>	°С/ Вт	62

### ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (T<sub>окр. ср.</sub> = 25°C)

Наименование электрического параметра, единица измерения	Обозначение	Режимы измерения	Нормы	
			Не менее	Не более
Пороговое напряжение, В	U <sub>зи пор</sub>	I <sub>с</sub> = 0,25мА, U <sub>зи</sub> = U <sub>си</sub>	2,0	4,0
Ток стока, А	I <sub>с</sub>	U <sub>си</sub> = 1,75В, U <sub>зи</sub> = 0В	50	-
		t <sub>и</sub> ≤ 300мкс, Q ≥ 50		
Сопротивление сток-исток в откры-том состоянии, Ом	R <sub>си отк.</sub>	I <sub>с</sub> = 31А, U <sub>зи</sub> = 10В t <sub>и</sub> ≤ 300мкс, Q ≥ 50	-	0,028
Остаточный ток стока, мкА	I <sub>с ост.</sub>	U <sub>си</sub> = 60 В, U <sub>зи</sub> = 0	-	250
Ток утечки затвора, нА	I <sub>з ут.</sub>	U <sub>си</sub> = 0, U <sub>зи</sub> = ±20 В	-	± 100I
Крутизна, А/В	S	U <sub>си</sub> = 25 В, I <sub>с</sub> = 31 А	15	
Постоянное прямое напряжение диода, В	U <sub>пр</sub>	U <sub>зи</sub> = 0, I <sub>с</sub> = 51А t <sub>и</sub> ≤ 300мкс, Q ≥ 50	-	2.5

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by) <http://www.transistor.by>